



Вопрос 2 Верно	На рисунке представлена схема энергетических зон полупроводника <i>n</i> – типа.
Баллов: 1,00 из 1,00	
1,00	A
	B
	• • • • • B
	Γ
	Буква В обозначает
	Выберите один ответ:
	уровень Ферми при 0 К
	донорный уровень
	о зону проводимости
	уровень Ферми при Т больше 0 К
	валентную зону
	Ваш ответ верный.
	Dail Crook Bophism
Вопрос 3	Укажите верные утверждения для полупроводника р-типа :
Верно	Transfer Bophible y Bophique In Horry Horson, India p 1711a.
Баллов: 1,00 из 1,00	Выберите один или несколько ответов:
1,00	
	 Энергия активации заряда равна половине энергии акцепторного уровня, отсчитанного от потолка валентной зоны
	Уровень Ферми при Т = 0° К находится между акцепторным уровнем и потолком валентной зоны ✓
	У Энергия активации заряда равна энергии акцепторного уровня, отсчитанного от потолка валентной зоны ✓
	Ваш ответ верный.
Вопрос 4	p-n-переход подключили к внешнему источнику тока, причем "+"
Верно	присоединили к р-полупроводнику, а "-" к п-полупроводнику.
Баллов: 1,00 из 1,00	Укажите последствия такого включения:
	Выберите один или несколько ответов:
	уровень Ферми в n-полупроводнике будет выше, чем в р-полупроводнике ✓
	тока <u>основных</u> носителей не будет
	ток <u>основных</u> носителей увеличится ✓
	ток <u>неосновных</u> носителей увеличится
	уровень Ферми в n-полупроводнике будет ниже, чем в p-полупроводнике
	Ваш ответ верный.

Ŋ,

Q

*

